

委 員 各 位

日本学術振興会ワイドギャップ半導体
光・電子デバイス第 162 委員会
委員長 吉川 明彦

日本学術振興会ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第 162 委員会
第 82 回委員会・第 86 研究会 開催案内

日時：平成 25 年 10 月 10 日（木） ※従来と曜日が異なりますのでご注意ください。

委 員 会：12:00 - 13:00

研 究 会：13:00 - 17:20

場所：名城大学名駅サテライト

(JR 名古屋駅 ユニモール地下街 4 番出口 すぐ)

〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-26-8 KDX 名古屋駅前ビル 13 階

TEL: 052-551-1666

<http://www.meijo-u.ac.jp/about/campus/msat.html>

委員会

議 題：

- (1) 前回第 81 回委員会議事要録承認について
- (2) 委員の異動について
- (3) 次回第 87 回研究会以降の研究会について
- (4) ワイドギャップ半導体スクール (10/24-10/26 開催予定) について
- (5) H24 年度収支計算書の一部修正
- (6) その他

報告事項：

- (1) 国際会議 IC-II-VI 2013 (2013/9/9-9/13@長浜ロイヤルホテル) 開催報告
- (2) その他

研究会

主 題：「ワイドギャップ半導体発光素子の課題と進展」

「委員長挨拶・企画の趣旨説明」(13:00-13:05)

1. 「ワイドギャップ半導体における点欠陥 - 計算科学からのアプローチ」(13:05-13:45)
大場 史康 (京都大学, 東京工業大学)
2. 「ワイドバンドギャップ窒化物・酸化物半導体の発光寿命と点欠陥の関係」(13:45-14:25)
秩父 重英¹、上殿明良² (1 東北大学、2 筑波大学)
3. 「キャリアオーバーフロー抑制に向けた np 接合 GaInN-LED」(14:25-15:05)
竹内 哲也¹、岩谷 素顕¹、上山 智¹、赤崎 勇^{1,2} (1 名城大学、2 名古屋大学)

休 憩(15:05-15:20)

4. 「InGaN-LED におけるキャリア輸送の面方位依存」(15:20-16:00)

川口 佳伸 (シャープ株式会社 研究開発本部)

5. 「ディスプレイ用高出力青・緑色半導体レーザー」(16:00-16:40)

長濱 慎一、柳本 友弥、枘井 真吾、三好 隆
(日亜化学工業株式会社)

6. 「可視光半導体レーザーの新しい応用 - レーザー照明、ディスプレイ -」
(16:40-17:20)

山本 和久 (大阪大学)

<追記>

1. 委員会では、出席のご回答をいただいた委員に昼食をご用意いたします。
2. 準備の都合上、委員会・研究会の出欠回答を9月30日(月)までに日本学術振興会研究事業課 檜崎 様 (jigyouka09@jstps.go.jp) 宛に、必ずご連絡くださいますようお願いいたします。